









	<h2>SI4214DDY-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4214DDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4214DDY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 61610 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4214DDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	61610 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 8.5A 3.1W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19.5 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4214DDY-T1-GE3-ND

SI4214DDY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4214DDY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4214DDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4214DDY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4214DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4214DY-T1-E3 VISHAY SI4214DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4214DDY-T1 VISHAY SI4214DDY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4214DY SI SI4214DY SI</p>
 <p>SI4214DDY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8SO</p>	 <p>SI4212-TRDX-EVB Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL DAUGHT CARD FOR SI4212</p>	 <p>SI4214DDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4214DDY-T1 VISHAY VISHAY SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

⚙️ SI4200-GMR	↔️ SI4200BM	➡️ SI4200DB-BMR	D SI4200DY-T1-E3	➡️ SI4201-BMR
⌄️ SI4201-GMR	⚙️ SI4202DY	D SI4205-BM	➡️ SI4205-BMR	➡️ SI4206-BM
⚙️ SI4206-BMR	⌄️ SI4208-A-GMR	⚙️ SI4208GM	↔️ SI4209-A-GMR	➡️ SI4210-C-GMR
D SI4210-D-GMR	⚙️ SI4210-GM	⌄️ SI4210DY-T1-E3	⚙️ SI4210DY-T1-GE3	➡️ SI4210DY-T1-GE3
➡️ SI4210GM	↔️ SI4214DDY	⚙️ SI4214DDY-T1-E3	⌄️ SI4214DDY-T1-E3	➡️ SI4214DDY-T1-GE3
↔️ SI4214DY-T1-E3	➡️ SI4214DY-T1-GE3	D SI4214DY-T1-GE3	⚙️ SI4220-GM	⌄️ SI4226DY
⚙️ SI4226DY-T1-E3	D SI4226DY-T1-E3	➡️ SI4226DY-T1-GE3	↔️ SI4226DY-T1-GE3	➡️ SI4228DY
⌄️ SI4228DY-T1-E3	⚙️ SI4228DY-T1-E3	↔️ SI4228DY-T1-GE3	➡️ SI4228DY-T1-GE3	➡️ SI4232DY.
⚙️ SI4276DY-T1-E3	⌄️ SI4276DY-T1-E3	⚙️ SI4282DVP	D SI4286DY	➡️ SI4286DY-T1-GE3
↔️ SI4286DY-T1-GE3	⚙️ SI4288DY	⌄️ SI4288DY-T1-GE3	⚙️ SI4288DY-T1-GE3	➡️ SI4300-BM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited